



・特徴

本装置はAr 中で2400℃まで加熱でき、半導体結晶表面改質後、装備のRHEED 電子銃にて表面構造をその場観察することを目的としています。またガス種を付属することでSiC 液相エピタキシャルや高温熱処理炉としても使用できます。

・仕様

到達圧力	×10 ⁻⁴ Pa 以下※常温・無負荷時
加熱温度	max2400℃
均熱帯	φ50mm×50mmH
圧力制御範囲	常圧～13.3Pa
加熱方法	高周波誘導加熱 高周波電源 30KHz30KW 整合器
真空排気系	ドライポンプ：500L/min ターボ分子ポンプ：550L/sec
真空計	サーモカップル真空計/電離真空計/バラトロン真空計
温度制御	放射温度計(500～3500℃) プログラム温度調節計
ガス制御	APC コントローラ/排気スロットルバルブ Ar マスフローコントローラ
試料昇降機構	上下昇降・回転機能
RHEED	VE-052S 蛍光スクリーン/防着シャッター/CCD カメラ
冷却水ユニット	
独立操作盤	